

MOS-P P沟道达林顿管 场效应管

产品名称	MOS-P P沟道达林顿管 场效应管
公司名称	厦门随源电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:MOS-PLY5801 种类:结型(JFET)
公司地址	厦门市思明区会展路508号101室
联系电话	86 0592 5933267 18059898591

产品详情

工作原理

场效应管工作原理用一句话说，就是“漏极-源极间流经沟道的 i_d ，用以门极与沟道间的pn结形成的反偏的门极电压控制 i_d ”。更正确地说， i_d 流经通路的宽度，即沟道截面积，它是由pn结反偏的变化，产生耗尽层扩展变化控制的缘故。在 $v_{gs}=0$ 的非饱和区域，表示的过渡层的扩展因为不很大，根据漏极-源极间所加 v_{ds} 的电场，源极区域的某些电子被漏极拉去，即从漏极向源极有电流 i_d 流动。从门极向漏极扩展的过度层将沟道的一部分构成堵塞型， i_d 饱和。将这种状态称为夹断。这意味着过渡层将沟道的一部分阻挡，并不是电流被切断。

在过渡层由于没有电子、空穴的自由移动，在理想状态下几乎具有绝缘特性，通常电流也难流动。但是此时漏极-源极间的电场，实际上是两个过渡层接触漏极与门极下部附近，由于漂移电场拉去的高速电子通过过渡层。因漂移电场的强度几乎不变产生 i_d 的饱和现象。其次， v_{gs} 向负的方向变化，让 $v_{gs}=v_{gs}(\text{off})$ ，此时过渡层大致成为覆盖全区域的状态。而且 v_{ds} 的电场大部分加到过渡层上，将电子拉向漂移方向的电场，只有靠近源极的很短部分，这更使电流不能流通。

本产品的品牌是国产，型号是MOS-PLY5801，种类是结型(JFET)，沟道类型是P沟道，导电方式是增强型，用途是S/开关，封装外形是CHIP/小型片状，材料是GE-P-FET锗P沟道，最大漏极电流是/，开启电压是/，夹断电压是/，低频噪声系数是/，极间电容是/，最大耗散功率是/